

中臺科技大學教師個人資料表

一、基本資料

中文姓名	陳冠蓁	英文姓名	Chen, Kuan-Chen (Last Name) (First Name) (Middle Name)
聯絡電話	校內分機： 04-22391647 轉 7415 (宅)：	(手機)：	
e-mail	107423@ctust.edu.tw		

二、主要學歷 請填學士級以上之學歷或其他最高學歷均可，若仍在學者，請在學位欄填「肄業」。

畢／肄業學校	國別	主修學門系所	學位	起訖年月(西元年/月)
逢甲大學	台灣	材料科學及工程學系	博士	2013/08 至 2016/06

三、現任系所及與專長相關之經歷 指與研究相關之專任職務，請依任職之時間先後順序由最近者往前追溯。

服務單位	職稱	起訖年月(西元年/月)
現職：		
中臺科技大學牙體技術暨材料系	助理教授級專案教師	2024/08 至 今
經歷：		
中臺科技大學牙體技術暨材料系	兼任助理教授	2018/02 至 2024/07
		/ _____ 至 _____ / _____
		/ _____ 至 _____ / _____

四、專長 請自行填寫與研究方向有關之學門名稱。

1. 活動義齒技術	2. 牙體型態	3. 牙科材料	4.
5.	6.	7.	8.

Representative Publication in 5 Years :**Journal Articles :**

1.

K.-C. Chen, K.-F. Chiu, C.-F. Chen, C.-Y. Lien, Y.-J. Tsai, T.-K. Lien, F. Matsunaga, M. Tanaka, K. Ogiwara, K. Uchino, and Y. Kawai, “Observation of bi-Maxwellian distributions in a H₂ plasma produced by a narrow gap VHF discharge”, *Plasma Process. Polym.* vol. 13, 6, pp. 584-587, June, 2016. (SCI,EI)

2.

K.-C. Chen, C.-F. Chen, C.-Y. Lien, K.-F. Chiu, J.-B. Shi, Y.-J. Tsai, T.-K. Lien, K. Ogiwara, K. Uchino, and Y. Kawai, “Axial distribution of a VHF H₂ plasma produced by a narrow gap discharge”, *Jpn. J. Appl. Phys.* vol. 55, pp. 01AH01-1-01AH01-5, January, 2016. (SCI,EI)

3.

K.-C. Chen, K. Ogiwara, K.-F. Chiu, L.-W. Su, K. Uchino, and Y. Kawai, “Two-dimensional simulations of a VHF H₂ plasma for different discharge gaps and gas pressures”, *Jpn. J. Appl. Phys.* vol. 55, pp. 07LD01-1-07LD01-6, July, 2016. (SCI,EI)

4.

K.-C. Chen, K.-F. Chiu, C.-F. Chen, C.-Y. Lien, Y.-J. Tsai, T.-K. Lien, K. Ogiwara, K. Uchino, and Y. Kawai, “Mechanism of VHF H₂ plasma production at high pressures”, *Jpn. J. Appl. Phys.* vol. 55, pp. 06HA02-1-06HA02-6, June, 2016. (SCI,EI)

5.

K.-C. Chen, K.-F. Chiu, K. Ogiwara, L.-W. Su, K. Uchino, and Y. Kawai, “Study of spatial profiles of capacitively coupled VHF H₂ plasma by simulation”, *Jpn. J. Appl. Phys.* vol. 56, pp. 01AC05-1-01AC05-8, January, 2017. (SCI,EI)

Conference Papers :

1.

K.-C. Chen, K.-F. Chiu, K. Ogiwara, L.-W. Su, K. Uchino, and Y. Kawai, “Two-dimensional simulations of a VHF H₂ plasma for different discharge gaps”, 68th Gaseous Electronics Conference (GEC)/9th International Conference on Reactive Plasmas (ICRP), October, 2015, vol. 60, pp. 82 (LW1 00027), American Society Applied Physics. Hawaii, U.S.A.

2.

K.-C. Chen, C.-F. Chen, C.-Y. Lien, K.-F. Chiu, J.-B. Shi, Y.-J. Tsai, T.-K. Lien, K. Ogiwara, K. Uchino, and Y. Kawai, “Mechanism of a VHF H₂ plasma production at high pressures”, 37th International Symposium on Dry Process (DPS), November, 2015, pp. 113-114 (p-26), Japan Society Applied Physics. Awaji Island, Japan.